	£1.	Формат	Зона	Поз.	Оδοз	ΉΩЧ	нени	е		Наименовани	ıe	Кол.	Приме- чание
	3.002									<u>Документация</u>			
нампии	PEYH. 94 16 13.002	*/			<u>РЕУН.468332.0</u>	101 C	<u>Б 2D</u>			Сборочный чертеж			*///Д,А2
Пепв	PEYH	*/			PEYH.468332.0	101 3	13 2D			Схема электрическая			*///Д,АЗ,А4
										принципиальная			
		*/			PEYH.468332.0	101 П	133 T3	)		Перечень элементов			*///Д,А4
		*/			PEYH.468332.0	101 B	П ТЭ			Ведомость покупных из	делий		*)ЛД,АЗ,А4
Cond N										<u>Сборочные единиц</u>	<u>'Ы</u>		
		*/		2	PEYH.687253.0	02 T	· 3			Плата печатная		1	*) ЛД,А4
										Прочие изделия	- -		
Г													
dama										Конденсаторы фирма К	етет,США		
Подо													
1/2				6						C1210C475K5RACTU		3	C22,C25,
MHB N GIIĞA													С26
$\vdash$													
N YHII				8						<u>C1210C476M4PACTU</u>		2	C36, C38
Взам инв											1		
טשנ													
Подо и дата			<u> </u>				l			DELULA (0.7.7	2 2 2 4	<del></del>	
Juli			1 /lu		N докум. Под		Дата			PEYH.46833.	2.001	ز /	
ngu			зрац 20в.			ndn. ndn.	10.06.22 10.06.22			лата		/ <u>lucm</u> 1	<b>Листов</b> 10
Разрао. Инв Моодл		11,500.						тер	MOC	табилизации			
<u></u>			mo.	<u> </u>	ιαυλιακύυ   110	UII.	110.00.22	Κοπι	<i>іровал</i>		<u>Форма</u>	ım A4	

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
			10		Конденсатор 08055D105КАТ2А	2	C28, C31
					фирма Kyocera AVX, США		
					Конденсаторы фирма Үадео, Тайвань		
			13		CC0603KRX7R7BB105	8	<u> </u>
							<i>C39</i>
			15		CC0603KRX7R9BB102	1	С23
			17		CC0603KRX7R9BB472	1	<i>C30</i>
	$\frac{1}{1}$				ECOODANA TIL TODO ET LA COLOR DE LA COLOR	,	
Подп. и дата			19		CC0603KRX7R9BB103	1	С27
N дубл. По	_		21		CC0603KRX7R9BB333	1	<i>C33</i>
Инв. Л			0.7		55040740450000404	47	
N	H	_	23		CC0603KRX7R9BB104	13	C1- C7, C15,
Взам. инв.	H						C16,C19,C2 C29,C35
та							
Подп. и дата	H		25		CC0603KRX7R9BB105	4	C18,C24,C.
Noi	$\coprod$						<i>C37</i>
Инв.N подл.			<b>_</b>				Λυι
Инв	Изм.	ſΙ	ІСП	N°докум. Подп. Дата	PEYH.468332.001 Т. <u></u>		2

	формат	Зона	<i>Поз.</i>	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
					Конденсаторы фирма Үадео, Тайвань		
			28		CC0603ZRY5V9BB224	1	C32
			30			1	C8
			00		CC1200NNXJN0DD100	'	LU
					Конденсаторы фирма Panasonic, Япония		
			33		EEE-FP1A221AP	1	C40
			7.		EEUZCALAOAD	1	C20
			35		EEHZC1H101P	'	C20
дата							
Nodn. u ó			37		Микросхема K7805-500R3	1	DA1
Пос					фирма Mornsun Power, Kumaū		
Ιδη							
И дубл.							
NHB.			39		Микросхема LT3741EFE#PBF	1	DA 7
>					фирма Analog Devices,США		
Взам. инв. N	-	$\vdash$					
Вза		_	41		Микросхема LMV321IDBVT	4	DA3,DA4,
a			, ,		фирма Texas Instruments, США	† T	DA6,DA8
Подп. и дата					, , ,		
Nodn.							
	_	_	43		Микросхема ТС4427СОА	2	DA5,DA9
одл					фирма Microchip, США		<u> </u>
Инв.N подл.	Изм	1. /lu	ırı	<b>N°докум.</b> Подп. Дата	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		/luc
	1,131	., ,,,		Копировал	Форма	ım A4	

	Формат	Зона	Поз.	Оδозначение		Наименование	Кол	Приме- чание
			45			Muunocyoma TI V7027708VT	1	DA2
			47			Микросхема TLV70233DBVT фирма Texas Instruments, США	,	DAZ
						gapria renas mon amemo, emr		
	-		47			Микросхема MAX232ID	1	DD2
						фирма Texas Instruments, США		
			49			Muurougumpo agon CTMZ2E0Z0C0T4	1	DD1
			77			<u> Микроконтроллер STM32F030C8T6</u> фирма ST Microelectronics, Малайзия	,	DDT
	╁					Светодиоды фирма Kingbright,Тайвань		
дата	H							
Подп. и а			52			APT1608CGCK	1	HL1
$\vdash$	╀							
И дубл.			53			APT1608EC	1	HL2
Инв.								
16. N								
Взам. инв. N			55			Ферритовая бусина BLM18TG102TN1D	1	L1
B	1					фирма Murata Electronics, США		
дата	$\vdash$							
Подп. и дата								
			57			Катушка индуктивности 7443551130	1	<i>L2</i>
одл.						фирма Wurth Elektronik,Германия		
Инв.И подл.	NSV	1. /IL	ICM	N°докум. Подп. Дата	PES	YH.468332.001 T		<i>Лисі</i> 4
	1			- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Копировал	Форма	m A4	

	Формат	Зона	Поз.	Оδозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
					Резисторы фирма Үадео, Тайвань		
						_	
			59		RC0603FR-070RL	4	R5-R7,R32
						+	
			61		RC0603FR-0710RL	2	R21,R34,R3
							R38
					D504075D 05444	+_	202124
			63		RC0603FR-071KL	4	R2,R4,R11,
							R12
						1	
			65		RC0603FR-074K7L	1	R18
	_						
מ						1	
и дата			67		RC0603FR-079K1L	1	R20
Nodn.						+	
<u>и</u> .	+		69		RC0603FR-0710KL	11	R1,R8-R10,
И дубл.							R13,R14,
Инв.							R16,R17,
×						_	R24,R28,R
						+	
Взам. инв.	igg		71		DC04.07FD 0.744IA	1	D10
			//		RC0603FR-0711KL	1	R19
, дата							
Подп. и дата			73		RC0603FR-0712KL	2	R31,R39
$\perp$							
оди.		_					
Инв.И подл.			$\pm$		PEYH.468332.001 T_	7	<i>fluc</i> 5
1	Изм	1. /1U	ст	N°докум. Подп. Дата Ко		1am A4	

	Формат	Зона	<i>Поз.</i>	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
					Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
			76		RC0603FR-0745K3L	1	R25
			78		RT0603DRD0765K5L	1	<i>R30</i>
			80		RC0603FR-07100KL	4	R3,R15,R27
							R29
			82		RC0603FR-07120KL	1	R23
дата			84		RC0603FR-07360KL	1	R22
Подп. и			86		RC0603FR-07680KL	1	R26
N дубл.							
Инв			88		Резистор CRCW2512100KFKEG фирма Vishay,США	2	R36, R37
Взам. инв. N							
B3			90		Потенциометр 3224W-1-103E	1	RP1
и дата					фирма Bourns,CШA		
Подп. и дата							
Инб.N подл.							Лис
Инв.N	Изм	1. /IU	יכוח	N°докум. Подп. Дата	PEYH.468332.001 ТЭ Копировал Форма		6

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
					фирма Diodes Incorporated,,США		
			94		Стабилитрон BZT52C3V3S-7-F	2	<i>VD2,VD5</i>
			96		Диод 1N4148WS-7-F	4	VD7, VD8, VD
							VD12
			98		Диод РМЕG6010CEH115	2	<i>VD3, VD4</i>
					фирма NXP Semiconductors,Китай		
					Диоды фирма ON Semiconductor, США		
a							
и дата			101		MBRA340T3G	2	<i>VD9,VD10</i>
Nodn.							
7	╀		103		SM05T1G	1	VD6
И дубл.			703		3/103/10	,	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Инв.							
	_						
инв. И			105		Диод SMAJ24CA-E3/61	1	VD1
Взам. инв.					фирма Vishay Semiconductors,США		
	$\vdash$						
дата							
Подп. и дата							
			_			_	
эдл.							
Инв.И подл.			+		PEYH.468332.001 T3	)	Лис
Ž	Изм	. /lu	cm	N°докум. Подп. Дата Копира			7

	Формат	Зона	<i>Поз.</i>	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
					Транзисторы фирма Infineon		
					Technologies Corporation,Германия		
			62		BSC011N03LSI	5	VT6-VT10
			64		BSC080N03LS G	1	VT11
					Транзисторы фирма ON Semiconductor, США		
			67		FDD6637	2	<i>VT1,VT2</i>
и дата			69		2N7002K	3	VT3-VT5
убл. Подп. и			71		Вилка L-KLS1-207C-2,50-2-10-S	1	X1
Инв. N дубл.					фирма KLS Electronic, Китай		
Взам. инв. N					Вилки фирма Molex, США		
			74		47053-1000	1	X8
Подп. и дата			76		87834-0819	1	X4
Инв.И подл.	1/2-			M°20, m,	 PEYH.468332.001 T	,	Лис 8
	<i>V13M</i>	ı. /lu	LM	№докум. Подп. Дата Копиро			

	Формат	Зона	Поз.	Обознач	ение		Наименование	2	Кол	Приме- чание
			78				<u>Клемма 1725656</u>		3	X5-X7
							фирма Phoenix Contact, Герм	10НИЯ		
	$\vdash$									
			80				Клемма РСВ7М3	4	4	X2,X3,X9,
							фирма Yuansichuang, Kumaū			X10
	$\vdash$									
П	╁									
дата										
ı. u dı										
Подп. и										
Z.	-									
И дубл.										
Инв										
$\vdash$	┺									
Взам. инв. N										
33aM. (										
	1									
ата										
Подп. и дата										
Πος	$\vdash$							_		
Z.	$\dagger$									
Инв.N подл.		Н	ightharpoons		Ш			<u></u>		Лис
Инв	Изм	ı. /lu	<u>cm</u>	N°докум. Подп.	Дата		YH.468332.001			9
					•	Копировал		Формат .	A4	

				Лист рег	гистрации	изменений			
Man		лера листов І	в (страниц)	i	Всего листов	Номер	Входящий номер сопрово-	Подпись	Дат
Изм.	ИЗМЕНЕН- НЫХ	ЗАМЕНЕН- НЫХ	новых	анулиро- ванных	(страниц) в документе	Номер документа	номер сопрово- дительного документа и дата		
$\dashv$									
	<u> </u>						004 ==	<u> </u>	
Изм.	Лист N до	кум. Поді	п. Дата	F	7E YH.4	68332.	001 T 3		//